Fe(Pt,Pd)薄膜の L1₀規則構造に及ぼすキャップ層及び形成条件の効果

Effects of Formation Condition and Cap-layer on the $L1_0$ Ordered Structure in Fe(Pt,Pd) Alloy Thin Films

> 電気電子情報通信工学専攻 有元 漠 Baku ARIMOTO

1. はじめに

近年,世界のデジタル情報量は急激に増加している.全世界のデジタル情報量は,2025年には163ZBまで増大する見通しで[1],情報記録装置の大容量化が求められている.

現在使用されている主な情報記録方式として磁気記録が 挙げられる.磁気記録による情報記録装置の代表がハードデ ィスクドライブ(Hard Disk Drive: HDD)である.HDDの記 録容量の増大のためには,記録ビットの微細化による記録密 度の向上が必要である.しかしながら,磁性微粒子の体積を 小さくすると,磁気エネルギーKuV(Ku:一軸磁気異方性エ ネルギー,V:磁性微粒子の体積)が減少することで,熱の 影響を受け磁化の反転が起こる熱ゆらぎが生じる.これによ りにより磁化の保持ができなくなる[2].したがって,記録密 度をさらに増大するために,高いKuを持つ磁性材料を用い て記録ビットを形成する必要がある.

高 Ku 磁性材料として注目されているのが $L1_0$ 型規則合金 である.特に $L1_0$ 規則化した $Fe_{50}Pt_{50}$ 合金や $Fe_{50}Pd_{50}$ 合金はそ れぞれ $6.6 \times 10^7 \text{ erg/cm}^3$ および $1.8 \times 10^7 \text{ erg/cm}^3$ [3, 4]と非常に高 い Ku を示す.これらの合金の薄膜を磁気デバイスへ応用す るためには規則度 S を高くすること,表面平坦性の向上,お よび磁化容易な結晶方位を揃える結晶配向の制御が必要と なる. $Fe_{50}Pt_{50}$ および $Fe_{50}Pd_{50}$ 合金薄膜をスパッタリング法 で作製すると, $L1_0$ 規則相へと変態させるには,材料中での 原子拡散を促進して安定構造の $L1_0$ 規則相への原子配列を実 現するための熱処理が必要となる.熱処理過程で, $L1_0$ 結晶 の c軸は面直を向いた $L1_0(001)$ 結晶と面内を向いた $L1_0(100)$ 及び $L1_0(010)$ 結晶が混在する可能性があるが,デバイス応用 のためには c軸の向きを一方向に制御する必要がある.

基板と薄膜材料との格子不整合を用いることで上述した L10型規則合金のc軸を制御することができる.基板上に薄 膜材料を形成させた場合,両者の結晶の格子定数が異なるた めに格子不整合が生じる.膜材料の格子定数に対して基板の 格子定数が大きい場合,基板から膜材料に対し引張応力が働 き,膜材料の面内方向の格子定数は膨張する.L10結晶の場 合,c軸方向に比べて,a軸方向の格子定数が大きいことか ら,格子不整合を用いることで面内引張応力が働き,結果と してc軸が面直を向いたL10(001)結晶への相変態を誘発させ ることが可能であると考えられる.

本研究では、 $Fe_{50}Pt_{25}Pd_{25}$ を用いて $L1_0$ 型規則合金の課題で ある結晶配向制御および高い規則度を持つ合金膜の形成を 試みる. $Fe_{50}Pt_{25}Pd_{25}$ 三元合金を用いたのは、前述したFePt 及びFePd合金のそれぞれの特徴を引き出すのが目的である. これまでの研究で,FePt 及びFePd 薄膜は詳細に調べられて おり,同様の条件で膜形成を行った場合,FePt 薄膜は Ku が 高いが,規則度が低く,FePd 薄膜は Ku が低いが,規則度が 高いという傾向がある.Fe₅₀Pt₂₅Pd₂₅ 三元合金を用いることで, 高規則度を保ちながら,高 Ku 磁性材料の開発を目指す.ま た,この磁性材料を記録媒体などに応用する場合,Pt 及び Pd の組成を変化させることによって,Ku 値の制御が可能に なると考えられる.Ku 値の制御は磁気記録媒体などの磁性 デバイスの設計上の重要要因である.

2. 実験方法

薄膜試料の作製に、反射高速電子回折(Reflection High Energy Electron Diffraction; RHEED)装置が取り付けられた超 高真空マグネトロンスパッタリング装置を用いた.到達真空 度は4×10⁻⁷ Pa以下である.直径3インチのFe₅₀Pt₂₅Pd₂₅ (at. %), および MgO ターゲットを使用した.基板として表面研磨を 施した(001)面の MgO 単結晶基板を用い、この MgO 基板は 表面清浄を行うため,製膜前に 600 ℃ で 1 時間の熱処理を行 った.本研究では2 種類の製膜法で膜形成を行った.基板温 度 600℃ での製膜(1 step 法),および基板温度 200 ℃ で製膜 を行った後,規則化のために 600 ℃ で熱処理(2 step 法)の 2 つの方法によって膜形成を行った.ターゲットと基板の距離 を 150 mm, Ar ガス圧を 0.67 Pa とし,膜形成速度が 0.020 nm/s とした.作製した試料の膜構造を RHEED および X 線回折 (XRD)により調べた.表面形態観察には原子間力顕微鏡 (AFM)を使用した.

3. Fe(Pt,Pd)合金薄膜に形成条件が及ぼす影響

薄膜形成条件が Fe(Pt,Pd)合金薄膜の膜構造及び結晶構造 に与える影響について調べた.まず初めに,Fe₅₀Pt₂₅Pd₂₅合金 薄膜を膜厚 2,10,40,100,500 nm として製膜した.膜形 成時は規則化を促進するために基板温度 600 ℃ (1 step 法)で 行った.その後,薄膜平坦化のために Fe₅₀Pt₂₅Pd₂₅合金薄膜を 基板温度 200 ℃ で形成した後基板温度を 600 ℃ で 1 時間の 熱処理を施す製膜方法 (2 step 法)を用いて膜形成を行った. そして,表面形態を,結晶構造及び規則度を系統的に調べた.

1 step 法で, Fe₅₀Pt₂₅Pd₂₅薄膜の膜厚を変化させ膜形成を行ったときの表面形態(AFM像)をFig.1に示す. 膜厚 2~40 nm 領域において膜厚が増加するのに伴い,算術平均表面粗

さ(Ra)値が増加する傾向が確認された.これは、高温で薄 膜形成をすることにより基板上での原子の熱拡散が促進さ れることで多数の原子が島状結晶を形成するが、膜厚増加に 伴い各島の体積が大きくなることで表面の起伏が大きくな るためであると考えられる.また膜厚 40 nm 以上の領域にお いて、算術平均表面粗さ(Ra)値が減少する傾向が確認され たが, 膜厚増加に伴い, 各島状結晶同士が結合することでさ らに大きな島状結晶が形成され,結晶粒子の境界の密度が低 減したためであると解釈される.表面電子線回折(RHEED) による観察を行った結果,全ての Fe50Pt25Pd25 膜がエピタキシ ャル成長していることが分かった. 基板温度 600 ℃ で形成し た Fe₅₀Pt₂₅Pd₂₅膜の面外 XRD パターンを Fig. 2(a-1)-(e-1)に, 面内 XRD パターンを Fig. 2(a-2)-(e-2)にそれぞれ示す. 規則 構造である L10 結晶からの超格子反射は面外 XRD パターン においては全ての膜厚でL10(001)反射が確認され, 面内 XRD パターンにおいては膜厚 40 nm 以上の領域において L1₀(100) 反射が確認された. このことから, Fe₅₀Pt₂₅Pd₂₅ 膜は膜厚 2~40 nm領域においてc軸が面直方向を向いたL10(001)結晶のみを 含み, 膜厚 40 nm 以上の領域においては L10(001)結晶に加え c 軸が面内方向をむいた L10(100) 及び L10(010)結晶が混在し ていることが分かる.

薄膜平坦化のために, 2 step 法で Fe50Pt25Pd25 薄膜の膜厚 を変化させ膜形成を行っときの AFM 像を Fig. 3 に示す.熱 処理前の薄膜において、いずれ膜厚でも平坦な表面となって いることが分かる.これは、低温基板温度で薄膜形成をする ことにより基板上での原子の表面拡散が抑えられたためで あると考えられる.熱処理後における薄膜の算術平均表面粗 さは、膜厚 10 nm 以上の領域では、表面平坦性は保たれるこ とがわかる. 試料の膜構造の解析を行うため, 2 step 法で形 成した FesoPt25Pd25 薄膜の熱処理後の FesoPt25Pd25 膜の面外 XRD パターンを Fig. 4(a-1)-(e-1)に, 面内 XRD パターンを Fig. 4(a-2)-(e-2)にそれぞれ示す.いずれの膜厚においても面外 XRD パターンから超格子反射である L10(001)反射が確認さ れた. また面内 XRD パターンにおいては膜厚 40 nm 以上の 領域において L10(100)反射が確認された. このことから, 2 step 法で形成した, 熱処理後の Fe50Pt25Pd25 膜は膜厚 2~40 nm 領域において c 軸が面直方向を向いた L10(001)結晶のみを含 み, 膜厚 40 nm 以上の領域においては L10(001)結晶に加え c 軸が面内方向をむいた L10(100)及び L10(010)結晶が混在して いることが分かる.



Fig. 1 AFM images observed for $Fe_{50}Pt_{25}Pd_{25}$ films of (a) 2, (b) 40, (c) 500 nm thicknesses deposited at 600 °C on MgO(001) substrates.



Fig. 2 (a-1)–(e-1) Out-of-plane and (a-2)–(e-2) in-plane XRD patterns measured for $Fe_{50}Pt_{25}Pd_{25}$ films of (a) 2, (b) 10, (c) 40, (d) 100, and (e) 500 nm thicknesses deposited at 600 °C on MgO(001) substrates.



Fig. 3 AFM images observed for $Fe_{50}Pt_{25}Pd_{25}$ films of (a) 2, (b) 40, and (c) 500 nm thicknesses (a-1) – (c-1) deposited at 200 °C and (a-2) – (c-2) annealed at 600 °C after deposition at 200 °C.



Fig. 4 (a-1)–(e-1) Out-of-plane and (a-2)–(e-2) in-plane XRD patterns measured for $Fe_{50}Pt_{25}Pd_{25}$ films of (a) 2, (b) 10, (c) 40, (d) 100, and (e) 500 nm thicknesses after annealing at 600 °C on MgO(001) substrates.

1 step 法及び 2 step 法で形成した Fe₅₀Pt₂₅Pd₂₅ 膜の結晶性に ついて比較を行なった. Fig. 5 に, 1 step 法で形成した Fe₅₀Pt₂₅Pd₂₅膜の, Fig. 6 に, 2 step 法で形成した Fe₅₀Pt₂₅Pd₂₅ 膜の格子定数(a, c, c/a)の膜厚依存性をそれぞれ示す. Fig. 5, 6 に示すように, 2 step 法で形成した薄膜の c/a 値は, 1 step 法で形成した薄膜の c/a 値と比較すると、10~40 nm 領域に おいて低い値となっている. Fig.7に1 step 法及び2 step 法 で形成した Fe50Pt25Pd25 膜の規則度 Sの膜厚依存性を示す.1 step 法及び 2 step 法で形成した Fe₅₀Pt₂₅Pd₂₅ (膜厚 = 2, 10, 40, 100, 500 nm)の規則度(S_{1 step}, S_{2 step})はそれぞれ, (0.35, 0.44), (0.21, 0.65), (0.20, 0.47), (0.32, 0.45), および(0.38, 0.38)であ った. このことから、2 step 法で膜形成を行うことにより、 L1a構造への規則化が促進されたと考えられる.この違いは、 薄膜が表面平坦になることにより、基板からの応力が一様に 働くことで格子定数が効果的に歪んだことによる. これによ り、L10構造への規則化に表面平坦性が重要な役割を担って いることが判明した.



Fig. 5 Lattice parameters of *a*, *c*, and c/a of $Fe_{50}Pt_xPd_{50-x}$ films prepared by 1 step method.



Fig. 6 Lattice parameters of *a*, *c*, and c/a of $Fe_{50}Pt_xPd_{50-x}$ films prepared by 2 step method.



Fig. 7 Order degree of $Fe_{50}Pt_{25}Pd_{25}$ film as a function of thickness

4. MgO キャップ層が Fe(Pt,Pd)合金薄膜に及ぼす影響

基板から薄膜へ応力が膜に効果的に伝わることで、規則度 が向上することが判明した. さらなる規則度向上のために、 薄膜上面からの応力を加えることが有効であると考えられ る.そこで、Fe₅₀Pt₂₅Pd₂₅合金薄膜上に2nm厚のMgOキャッ プ層導入し、MgOキャップ層の規則度への効果を調べた.

3 章で説明した実験方法と同様に、MgO キャップ層を導入 した Fe₅₀Pt₂₅Pd₂₅合金薄膜においても膜厚 2 ~ 500 nm の範囲 で変化させて形成した.熱処理前と熱処理後のそれぞれの AFM 像を Fig. 8 に示す.熱処理の有無に関わらず,いずれの 膜厚においても算術平均表面粗さ (*Ra*) 値が 1 nm 以下と小 さく、平坦な表面となっていることが分かる.MgO キャッ プ層を導入し、2 step 法で形成した熱処理後の Fe₅₀Pt₂₅Pd₂₅ 膜の面外 XRD パターンを Fig. 9(a-1)-(e-1)に、面内 XRD パタ ーンを Fig. 9(a-2)-(e-2)にそれぞれ示す.いずれの膜厚におい ても面外 XRD パターンから超格子反射である $L1_0(001)$ 反射 が確認された.また面内 XRD パターンにおいては膜厚 100 nm 以上の領域において $L1_0(100)$ 反射が確認された.これによ り、MgO キャップ層導入は、*c* 軸が面直方向を向いた $L1_0(001)$ 結晶の形成促進に効果があることがわかった.

Fig. 10 に, MgO キャップ層を導入し, 2 step 法で形成した Fe₅₀Pt₂₅Pd₂₅膜の格子定数(a, c, c/a)の膜厚依存性をそれぞれ示 す. Fig. 10 に示すように、キャップ層が有りの場合、キャッ プ層が無しの場合と比べて, c/aの値は低い傾向にあること が分かる.キャップ層から薄膜へ格子不整合による応力が働 いたことがわかる. Fig. 11 に MgO キャップ層を導入し, 2 step 法で形成した Fe₅₀Pt₂₅Pd₂₅膜の規則度 S の膜厚依存性を示す. キャップ層有り及びキャップ無しの場合の, Fe50Pt25Pd25 (膜 厚 = 2, 10, 40, 100, 500 nm)の規則度($S_{w/}, S_{w/a}$)はそれぞれ, (0.53, 0.44), (0.81, 0.65), (0.79, 0.47), (0.68, 0.45), および(0.49, 0.38)であった. キャップ層有りの Fe₅₀Pt₂₅Pd₂₅ 膜の規則度は, キャップ増が無しの FesoPt, Pd, 膜に比べて, 高規則度である ことが分かった. 膜厚が 10~40 nm 領域で高い値となってい ることがわかる. このことから, MgO キャップ層を用いて 膜形成を行うことは,高規則化を促進する効果があったと認 められた.



Fig. 8 AFM images observed for $Fe_{50}Pt_{25}Pd_{25}$ films of (a) 2, (b) 40, and (c) 500 nm thicknesses with MgO cap-layer (a-1) – (c-1) before and (a-2) – (c-2) after annealing.



Fig. 9 (a-1)–(e-1) Out-of-plane and (a-2)–(e-2) in-plane XRD patterns measured for $Fe_{50}Pt_{25}Pd_{25}$ films with MgO cap-layer of (a) 2, (b) 10, (c) 40, (d) 100, and (e) 500 nm thicknesses after annealing on MgO(001) substrates.



Fig. 10 Lattice parameters of *a*, *c*, and c/a of Fe₅₀Pt₂₅Pd₂₅ films with and without cap-layer prepared by 2 step method.



Fig. 11 Order degree of ${\rm Fe}_{50}{\rm Pt}_{25}{\rm Pd}_{25}$ films with and without cap-layer

5. まとめ

本研究では、L1₀型規則合金の課題解決に向け、Fe(Pt,Pd) 薄膜のL1₀規則構造に及ぼす薄膜形成方法,膜厚,及びキャ ップ層の効果を調べた.初めに.MgO(001)単結晶基板上に Fe₅₀Pt₂₅Pd₂₅膜を1step法及び2step法で形成し、形成方法及 び膜厚が、表面平坦性、バリアント構造、格子定数、及び規 則度にそれぞれが与える影響について系統的に調べた.表面 平坦性がL1₀規則化の重要な役割を担うことがわかった.次 に、MgOキャップ層を設けたFe₅₀Pt₂₅Pd₂₅膜を2step法で形 成し、MgOキャップ層及び膜厚の膜構造、表面平坦性、バ リアント構造、格子定数、及び規則度への効果について調べ た.MgOキャップ層導入することで、薄膜の表面平坦性及 び規則度が向上することが判明した.本研究によって明らか になったエピタキシャル成長機構、平坦表面L10型規則合金 膜形成手法、c軸方位分散制御技術が磁気応用デバイスの発展 に寄与することが期待される.

謝辞 本研究を行う上で、多くの方のご協力を頂き頂きました.ここに感謝の意を表します.指導教員である二本正昭教授には、実験方針や論文指導などの丁寧なご指導を頂きました.工学院大学の大竹充先生には、実験装置の使用方法や薄膜の基礎知識など、多くのことを教えて頂きました.共同研究員である川井哲郎氏には、研究進めていく中で、重要な助言を頂きました.研究室の仲間達とは、共に協力しながら研究に取り組み、多くの場面で支えあうことができました.

参考文献

1)D. Reinsel, J. Grants, and J. Rydning: "Data Age 2015: The Evolution of Data to Life-Critical"(2017),

https://www.seatage.com/jp/ja/our-story/data-age-2025/.

2) D. Weller, G. Parker, O. Mosendz, A. Lyberatos, D. Mitin, N. Y. Safonova, and M. Albrecht: *J. Vac. Sci. Technol.*, **34**, 060801(2016)

3) A. Ye, Yermakov and V. V. Maykov, *Phys. Met. Metall.*, **69**, 198 (1990).
4) K. Sato, B. Bian, and Y. Hirotsu, *J. Appl. Phys.*, **91**, 8516 (2002).5) L. Gao, L. P. Yue, T. Yokota, R. Skomski, S. H. Liou, H. Saito, and S. Ishio: *IEEE Trans. Magn.*, **40**, 2194 (2004).

5) M. Ohtake and M. Futamoto: IEEE Trans. Magn., 50, 1(2014).

6) H. Okamoto ed, *Phase Diagrams for Binary Alloys*, ASM International, Materials Park, OH, 370–371 (2000).

7) M. Futamoto, M. Nakamura, M. Ohtake, N. Inaba, and T. Shimotsu: *AIP Advances*, **6**, 085302(2016).